



Photoresists for EUV and e-beam microlithography

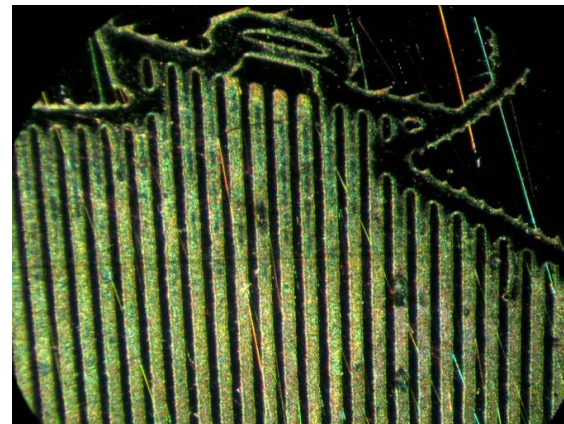
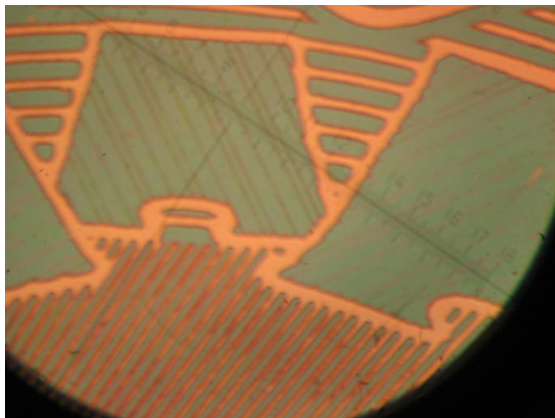
R&D products

PMMA resists

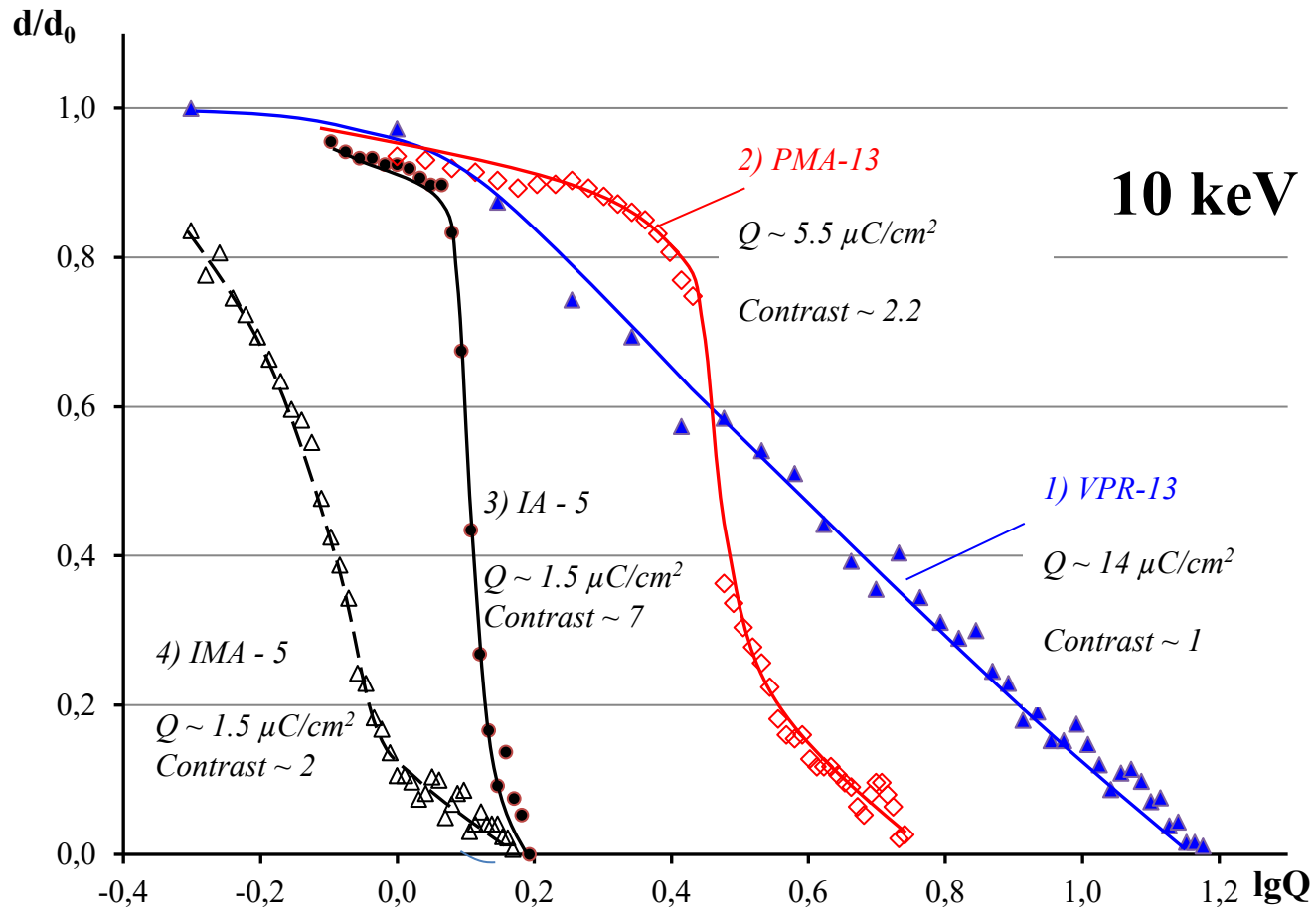
E-beam resists

Chemically amplified
resists for DUV
lithography

Resists for EUV
lithography
($\lambda=13.5$ nm)



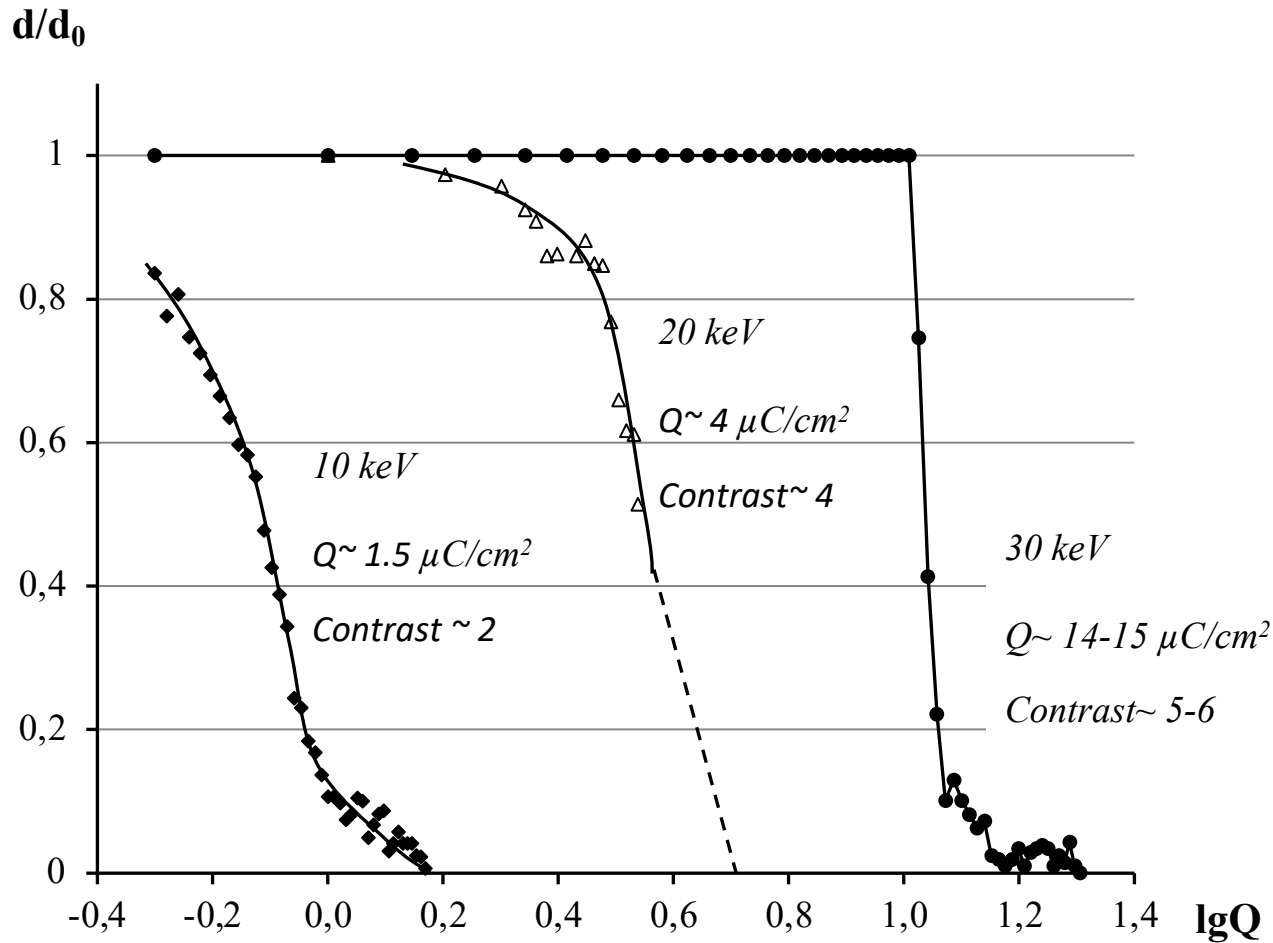
E-beam photoresists



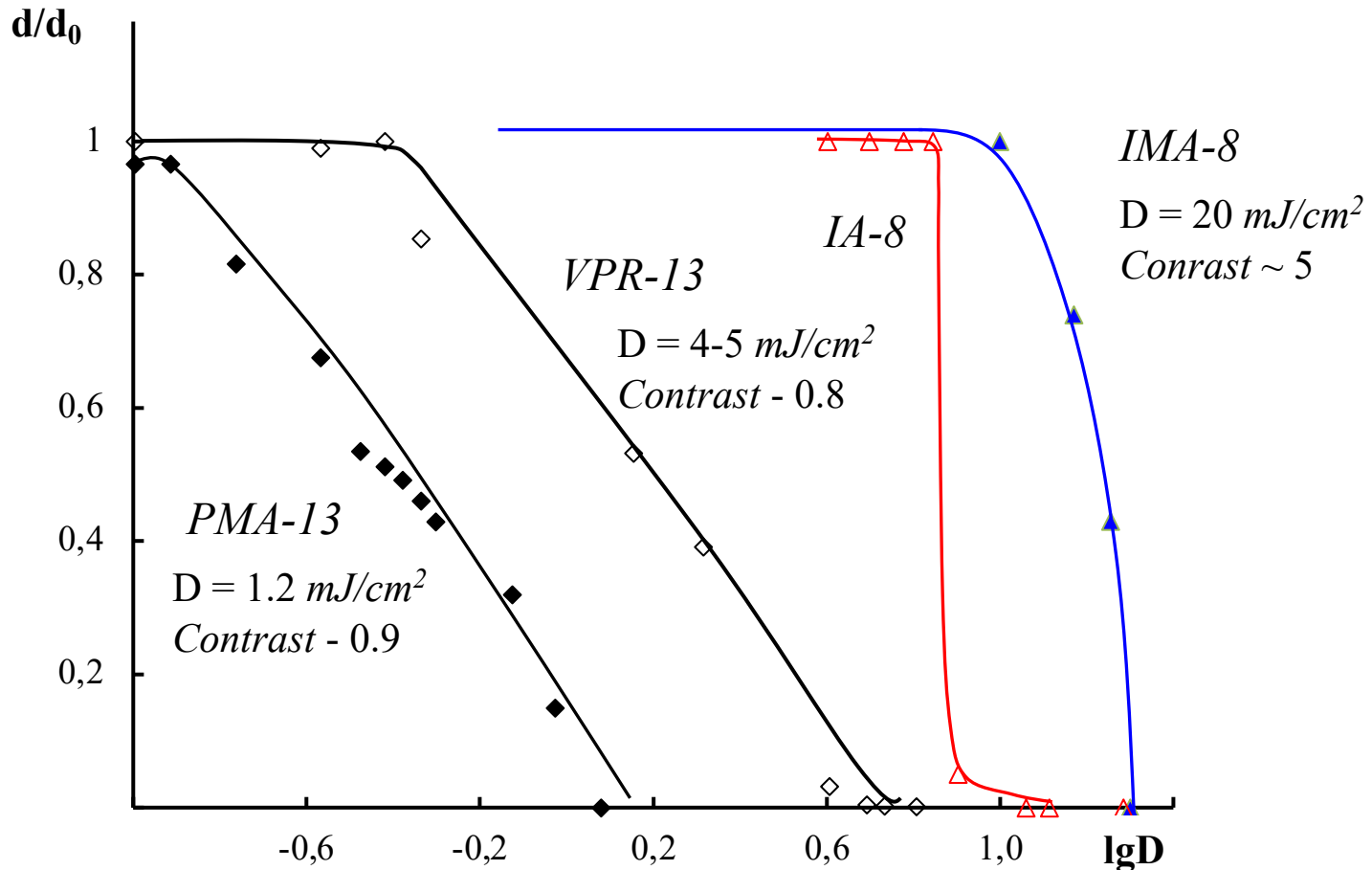
E-beam photoresists

10 keV	Contrast	Sensitivity, $\mu\text{C}/\text{cm}^2$
IA-5	7	1,5
IMA-5	2	1,5
TPR-20	1,5	3
PMA-13	2,2	5,5
TB-40	1,7	7
VPR-13	1	14

IMA-5 resist for e-beam lithography



EUV photoresists for 13.5 nm source





POLY KETONE

Photopolymerization
innovation polymer

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2692678

**Фоторезистивная композиция высокочувствительного
положительного электронорезиста**

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью
"Поликетон" (RU)*

Авторы: *Колмогоров Юрий Николаевич (RU),
Джонс Михаил Михайлович (RU)*

Заявка № 2019102641

Приоритет изобретения 30 января 2019 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 26 июня 2019 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 30 января 2039 г.

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

Г.П. Ивлиев

